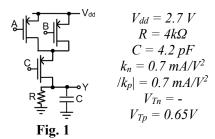
Fondamenti di Elettronica - Ingegneria Elettronica - a.a. 2023/24 Primo appello - 15 luglio 2024

- 1. Riportare sulla prima pagina del foglio protocollo nome, cognome, numero di matricola, cod. persona. data, "Primo Appello", numero totale di fogli consegnati.
- 2. Numerare tutti i fogli e riportare su ciascuno almeno nome, cognome, numero di matricola, cod. persona.
- 3. Scrivere con grafia leggibile e con la penna
- 4. Indicare chiaramente la domanda a cui si sta rispondendo. Ad esempio 1a)...
- 5. Risolvere per primi i punti in grassetto, perche' ritenuti piu' facili. La durata della prova e' 2.5 ore.
- 6. Non sono ammessi libri o appunti o altro materiale, eccetto la calcolatrice.

Esercizio 1

Si consideri il circuito logico riportato nella Fig. 1.

- a) Determinare la funzione logica svolta dal circuito logico e disegnare la rete di *pull-down* da sostituire alla resistenza *R* per realizzare la corrispondente porta in tecnologia *CMOS*.
- b) Determinare il tempo di transizione 20%-80% della tensione di uscita V_{out} nel circuito logico di Fig. 1 e nella corrispondente porta logica CMOS, a seguito della commutazione $A = B = C = 0 \implies A = B = C = 1$.
- c) Determinare il valore logico ed il corrispondente valore analogico di V_{out} per A = C = 1 e B = 0 e per A = B = C = 0.



Esercizio 2

Si consideri la catena di acquisizione per la misura di temperatura tramite un sensore resistivo $R(T) = R_0 + \alpha T(^{\circ}C)$ con $R_0 = 100\Omega$ e $\alpha = 0.39\Omega/^{\circ}C$, mostrata in Fig. 2. L'ADC sia del tipo *tracking*. Gli amplificatori operazionali saturino alle tensioni di alimentazione e *I* sia un generatore di corrente *DC*.

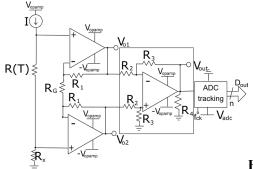


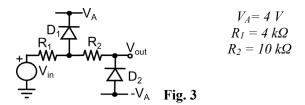
Fig. 2

$R_G = 1 \ k\Omega$	$R_x = 1 \ k\Omega$
$R_I = 10 k\Omega$	$I = 100 \mu A$
$R_1 = 10 \text{ ksz}$ $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$	$V_{adc} = -6V$
$R_3 = 20 \ k\Omega$	$V_{opamp} = 18 V$
$R_4 = 1 \ k\Omega$	n = 13 bits

- a) Determinare l'espressione letterale e con i coefficienti numerici della tensione V_{out} in funzione della temperatura T espressa in gradi centigradi (°C).
- b) Determinare la variazione di temperatura erroneamente misurata se tutti gli amplificatori operazionali sono caratterizzati da una tensione di *offset* pari a ± 0.2 mV.
- c) Con solo riferimento al circuito nel riquadro tratteggiato, determinarne il margine di fase, se fosse presente una capacita' di carico pari a 80 pF in parallelo alla resistenza di carico R_4 e se l'amplificatore operazionale fosse caratterizzato da una resistenza di uscita ad anello aperto $r_0 = 10 \Omega$ e da un prodotto guadagno larghezza di banda GBWP = 20MHz.
- d) Determinare la minima frequenza di *clock* (f_{ck}) che possa garantire una risoluzione di $0.1^{\circ}C$ e possa seguire una variazione di temperatura pari a 10 °C/s per temperature nell'intervallo [0°C, 100°C].

Esercizio 3

Si consideri il circuito riportato in Fig. 3. I diodi conducono quando sono polarizzati in diretta con una tensione ai loro capi pari a $0.7 \ V$. V_{in} sia un generico segnale di tensione con valori che variano nell'intervallo $[-5 \ V, +5 V]$. Tracciare, quotandone tutti i punti significativi, l'andamento della caratteristica di trasferimento statica V_{out} vs V_{in} . Si giustifichi la risposta.



Esercizio 4

Si consideri il circuito a *MOSFET* riportato nella Fig. 4, in cui v_{in} e' un generatore di tensione di piccolo segnale e V_B e' un generatore di tensione DC.

- a) Determinare la tensione V_B necessaria perche' la transconduttanza del MOS M1 sia pari a 2mS Determinare, quindi. la polarizzazione del circuito (tensioni a tutti i nodi e correnti in tutti i rami) e indicare l'intervallo di valori permesso per la tensione di uscita in DC.
- b) Tracciare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento di piccolo segnale v_{out}/v_{in} , quotandone tutti i punti significativi. Si assuma per il solo MOS M2, r_0 =100 $k\Omega$.

